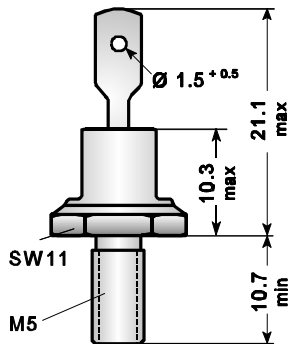


Silicon-Power Rectifiers

Silizium-Leistungs-Gleichrichter



Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	12 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Metal case – Metallgehäuse	DO-4
Weight approx. – Gewicht ca.	5.5 g
Recommended mounting torque Empfohlenes Anzugsdrehmoment	18 ± 10% lb.in. 2 ± 10% Nm
Standard:	Cathode to stud / am Gewinde
Index R:	Anode to stud / am Gewinde (e.g. 1N 1199 A/R)

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
1N 1199 A PBY 271	50	60
1N 1200 A PBY 272	100	120
1N 1202 A PBY 273	200	240
1N 1204 A PBY 274	400	480
1N 1206 A PBY 275	600	720
1N 3671 PBY 276	800	1000
1N 3673 PBY 277	1000	1200

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$	I_{FAV}	12 A ¹⁾	
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	40 A ¹⁾	
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$	i^2t	240 A ² s	
Peak fwd. half sine-wave surge current, superimposed on rated load	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$ $T_A = 25^{\circ}\text{C}$	$f = 60\text{ Hz}$ $f = 50\text{ Hz}$	I_{FSM} I_{FSM}	240 A 220 A
Stoßstrom für eine Sinus-Halbwellen, überlagert bei Nennlast				

¹⁾ Valid, if the temp. of the stud is kept to 100°C – Gültig, wenn die Temp. am Gewinde auf 100°C gehalten wird

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	– 65...+175°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	– 65...+175°C

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 30\text{ A}$	V_F	< 1.5 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 100 μA
Thermal resistance junction to stud Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	< 2 K/W